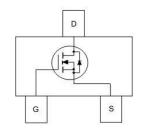


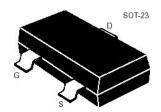
安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

FSS2302S

SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)





N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極–源極電壓	$\mathrm{BV}_{\mathrm{DSS}}$	20	V
Gate- Source Voltage 栅極-源極電壓	$ m V_{GS}$	<u>±</u> 10	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	I_{D}	2.5	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲	I_{DM}	12	A
Total Device Dissipation 總耗散功率 TA=25℃環境溫度爲 25℃	P_{D}	1000	mW
Junction 結溫	$T_{ m J}$	150	$^{\circ}$
Storage Temperature 儲存溫度	$T_{ m stg}$	-55to+150	$^{\circ}$ C

■ DEVICE MARKING 打標

FSS2302S=A2SHB.



安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

FSS2302S

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓(I _D = 250uA,V _{GS} =0V)	BV _{DSS}	20	22	_	V
Gate Threshold Voltage 栅極開启電壓(I _D =250uA,V _{GS} = V _{DS})	V _{GS(th)}	0.5		1.5	V
Diode Forward Voltage Drop 内附二極管正向壓降(I _s =0.75A,V _{GS} =0V)	V_{SD}	_	_	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= 16V) (VGS=0V, VDS= 16V, TA=55℃)	I _{DSS}	_	_	1 10	uA
Gate Body Leakage 栅極漏電流(V _{GS} = <u>+</u> 10V, V _{DS} =0V)	IGSS	_	_	<u>±</u> 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(I _D = 3.6A,V _G S= 4.5V)	R _{DS(ON)}		55	65	mΩ
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(I _D = 2A,VGS= 2.5V)	R _{DS(ON)}	_	65	80	mΩ
Input Capacitance 輸入電容 (VGS=0V, VDS= 10V,f=1MHz)	CISS		600	_	pF
Output Capacitance 輸出電容 (VGS=0V, VDS= 10V,f=1MHz)	Coss	_	120	_	pF
Turn-ON Time 开启時間 (VDS= 10V, ID= 3A, RGEN=6Ω)	t(on)		8		ns
Turn-OFF Time 关断時間 (VDS= 10V, ID= 3A, RGEN=6Ω)	t(off)	_	60	_	ns

Pulse Width≤300µs; Duty Cycle≤2.0%



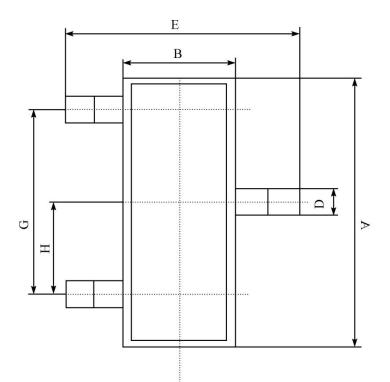
安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

FSS2302S

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
В	1.30 ± 0.10
С	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
Е	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
Н	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60 ± 0.10
P	7±2°

